UNIVERSIDADE PEDERAL DO CEARÃ

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

"ESTUDO DE CRISTAIS DE HALOGENETOS ALCALINOS IMPURIFICADOS COM IONS CIANETO E IONS DIVALENTES".

Autor:

Francisco Hélio Germano Correia

Orientador:

Dr. José Evangelîsta C. Moreîra

Trabalho apresentado ao Departamento de Física da Universidade Federal do Ceara para obtenção do título de Mestre.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação Universidade Federal do Ceará Biblioteca Universitária Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

C847e Correia, Francisco Hélio Germano.

Estudo de cristais de halogenetos alcalinos impurificados com íons cianeto e íons divalentes / Francisco Hélio Germano Correia. – 1981. 54 f. : il.

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Programa de Pós-Graduação em Física, Fortaleza, 1981. Orientação: Prof. Dr. José Evangelista de Carvalho Moreira.

1. Condutividade elétrica. 2. Cristais. I. Título.

CDD 530

"ESTUDO DE CRISTAIS HALOGENETOS ALCALINOS IMPURIFICADOS COM Ions cianeto e Ions divalentes"

C349682 P837288

Francisco Hélio Germano Correia

530 7 P C847 P

> Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Ceará, como parte dos requisitos para obtenção do Grau de Mestre em Física.

Comissão Julgadora:

José Evangelista de Carvalho Moreira (UFC) Orientador

Milton Ferreira de Souza - São Carlos(USP)

Francisco Flavio Tôrres de Araújo (UFC)

Aprovada em, 17 de Julho de 1981.

-	Ĩ	N	D	Ī	<u>C</u>	E

adding to

ABSTRACT	····· · · · · · · · · · · · · · · · ·
RESUMO	····· · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAPÍTULO 1	
1. Introdução	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. Considerações Gerais	
2.a) Condutividade Iônica	
2.b) Re-Orientação dos dipolos I-V	
3. Correntes Termo-Iônicas (ITC)	
4. Cristais duplamente dopados	
CAPITULO 2: TECNICAS EXPERIMENTAIS	
l. Amostras	
2. ITC	
 Condutividade 	18
	and a state of the
CAPÍTULO 3: RESULTADOS EXPERIMENTAIS	
a) - ITC	
b) - Condutividade	
Figuras	
Tabelas	
Tabelas CAPITULO 4: DISCUSSÃO	
TabelasCAPÍTULO 4: DISCUSSÃOa) Influência do ion CN na reorienta	35 cão dos complexos I-V 37
Tabelas <u>CAPÍTULO 4</u> : DISCUSSÃO a) Influência do ion CN ⁻ na reorienta b) Influência do ion CN ⁻ na condutivi	ção dos complexos I-V 37 dade iônica 40
Tabelas <u>CAPÍTULO 4</u> : DISCUSSÃO a) Influência do ion CN [®] na reorienta b) Influência do ion CN [®] na condutivi c) Agregação das Impurezas	ção dos complexos I-V 35 dade iônica 40
Tabelas <u>CAPÍTULO 4</u> : DISCUSSÃO a) Influência do ion CN [®] na reorienta b) Influência do ion CN [®] na condutivi c) Agregação das Impurezas d) Bandas de ITC em baixas temperatur	ção dos complexos I-V 35 dade iônica 40 42 as 43
Tabelas <u>CAPÍTULO 4</u> : DISCUSSÃO a) Influência do ion CN ⁻ na reorienta b) Influência do ion CN ⁻ na condutivi c) Agregação das Impurezas d) Bandas de ITC em baixas temperatur	ção dos complexos I-V 35 dade iônica 40 42 as 43
Tabelas CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO a) Influência do ion CN na reorienta b) Influência do ion CN na condutivi c) Agregação das Impurezas d) Bandas de ITC em baixas temperatur <u>CAPÍTULO 5:</u> CONCLUSÕES	ção dos complexos I-γ 35 dade iônica 40 42 as 43
Tabelas CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO a) Influência do ion CN na reorienta b) Influência do ion CN na condutivi c) Agregação das Impurezas d) Bandas de ITC em baixas temperatur <u>CAPÍTULO 5</u> : CONCLUSÕES APÊNDICE	ção dos complexos I-V 35 dade iônica 40 42 as 43 45 45

<u>A G R A D E Ç O</u>

- Ao Professor José Evangelista C. Moreira pela valiosa orientação e empenho.

- Ao Instituto de Física e Química de São Carlos, na pessoa do Professor Milton Ferreira de Souza, pela ajuda em t<u>o</u> das as fases deste trabalho.

- Ao Professor Francisco Alcides Germano pela confecção do programa de computador e conselhos.

- Aos Professores Julio Auto Neto e Lindberg Lima Gonçal-

- Ao Euclides pela ajuda no laboratório e discussões.

- Ao Antonio Barros e Barreto pelo apoio técnico recebido.

- Ao Romeu, Milton, Fatima, Creuza e Vera pelos bons serviços de secretaria, datilografia e biblioteca.

- Aos amigos do Departamento de Física que direta ou indiretamente participaram deste trabalho.

- Ao apoio financeiro recebido da FINEP e CNPq.

<u>A B S T R A C T</u>

Ionic thermal currents (ITC) and electrical conductivity were used to study crystals of alkali halides doped with divalent impurities and with cyanide (CN⁻) ions.

The presence of the CN⁻ ion creates a depolarization peak in Ca⁺⁺ and Sr⁺⁺ doped crystals of KBr + 1% KCN.

The study of aging in samples of KBr + 1% KCN + 10^{-3} CaBr₂ shows that the CN⁻ ion acts as a trap for the impurity-vacancy complex.

There is a decrease in the association energy for the pair impurity-vacancy due to the influence of the CN^- ion. The pertinent energies in a barrier model are proposed for the KBr + 1% KCN + 10^{-3} CaBr₂ crystal.

RESUMO

Medidas de correntes termoiônicas (ITC) e condutividade elétrica, foram usadas no estudo de cristais de halogenetos a<u>l</u> calinos com impurezas divalentes e ions cianeto (CN⁻).

A presença do ion CN⁻ faz aparecer uma banda de despolarização nos cristais de KBr + 1% KCN dopados com Ca⁺⁺ e Sr⁺⁺.

O estudo de envelhecimento feito em amostras de KBr + 1% KCN + 10⁻³ CaBr₂ comprovam que o ion CN⁻ serve de arm<u>a</u> dilha para o complexo impureza-vacância.

Devido a influência do ion CN^- hã uma diminuição na energia de associação entre o ion divalente e a vacância. As energias pertinentes em um modelo de barreiras foram propostas para o cristal de KBr + 1% KCN + 10⁻³ CaBr₂.

1. INTRODUÇÃO:

A introdução de uma impureza divalente em um cristal i<u>ô</u> nico tipo halogeneto alcalino provoca o surgimento de uma vacância de ion positivo, devido a condição de neutralidade da carga elétr<u>i</u> ca no cristal¹. A interação coulombiana obriga a vacância a ocupar posições próximas ao ion divalente, formando um complexo impurezavacância, o qual trataremos por complexo I-V (fig. 1). Tais compl<u>e</u> xos possuem propriedades dipolares (elétrica e mecânica) estáveis, mesmo em temperaturas acima da ambiente. Estas propriedades foram bem estudadas nestes ultimos anos, usando-se técnicas como perda dielétrica, corrente termo-ionicas (ITC), relaxação dielétrica, etc.



FIGURA 1

Se, além da impureza divalente, for introduzida uma outra impureza monovalente negativa na rede, essa nova impureza pode ocupar, substitucionalmente, a posição de um ânion. Para vários sistemas ja estudados foi verificado que a impureza monovalente se tiver um raio iônico diferente do ânion ao qual substituiu, pode capturar um ion divalente formando uma entidade mais ou menos esta ver que modifica as proprieuades de relaxação e de mobilidade do

complexo I-V.

Nesse trabalho estudamos alguns sistemas de halogenetos alcalinos contendo impurezas divalentes e fons CN⁻. Verificamos que os fons CN⁻ comportam-se como armadilhas na captura dos com plexos impureza-vacância. A presença do fon CN⁻ nas vizinhanças do divalente facilita a reorientação e aumenta a mobilidade da v<u>a</u> cância compensadora de carga nas faixas de temperatura em que essas três entidades estão ligadas. Com isso aumenta a rapidez com que os fons de impureza divalente se agregam levando, em alguns casos, a uma rápida precipitação dessas impurezas em agregados de<u>n</u> tro da matriz.A forma elipsoidal do fon CN⁻ não parece ter nenhum efeito nas propriedades estudadas o que era de se esperar jã que o CN⁻ se orienta rapidamente entre as 8 direções < 111 >. Deste modo, em relação ãs técnicas experimentais utilizadas nesse trabalho,que foram técnicas de resposta lenta, o fon CN⁻ comporta-se como um ion esférico, semelhante ao C1⁻.

Uma comparação dos nossos resultados com outros obtidos em halogenetos alcalinos com impurezas mono e divalentes, ob tidos por vários pesquisadores, mostrou que o ion CN⁻ parece se comportar como um ion esférico com raio (efetivo) da ordem do raio iônico do Cl⁻ ou ligeiramente menor.

E possível, além disso, que esse ion CN⁻ esteja lige<u>i</u> ramente deslocado em sua posição substitucional, para algum dos sistemas estudados.

2. Considerações Gerais

Faremos a seguir um relato sucinto dos resultados jā conhecidos em sistema de halogenetos alcalinos com impurezas div<u>a</u> lentes.

Dado a quantidade enorme de conhecimentos ja acumulados

nessa **ārea de estudo v**amos nos referir apenas a um pequeno número de informações que podem ter alguma relevância em relação ao nosso trabalho. Falaremos inicialmente de sistemas constando de halogen<u>e</u> tos alcalinos contendo apenas impurezas divalentes.

Para a grande maioria de impurezas jā estudadas, pode-se afirmar que a vacância estā sempre em uma posição vizinha mais próxima (nearest neighbour - nn) ou próxima do vizinho mais próximo (next nearest neighbour - nnn) e que a orientação do dipolo I-V, em um campo elétrico, ocorre principalmente devido ao movimento de vacâncias ao redor da impureza ². Este movimento é descrito por equações diferenciais¹ em termos de quatro frequências diferentes de saltos: ω_1 corresponde ao salto da vacância de uma posição nn p<u>a</u> ra outra nn, ω_2 corresponde a troca direta entre a vacância e a impureza divalente, ω_3 é a frequência de salto da vacância de uma posição nn sição nnn para uma nn e ω_4 ao salto da vacância de uma posição nn para outra nn.

Todos estes processos são termicamente ativados e a relação entre as frequências de salto e a temperatura é dada por:

$$\omega = \omega_{e} e \frac{\Delta \varepsilon}{KT}$$

onde ω_o ē a frequência tentativa para a vacância vencer a barreira de potencial com altura Δε e K ē a constante de Boltzmann e T ē a temperatura absoluta.

As equações de Lidiard foram resolvidas, para um campo elétrico constante, por Dreyfus³, obtendo dois tempos que governam o processo de relaxação:

$$\tau_{1}^{-1} = \omega_{1} + \omega_{2} + 2\omega_{3} + \omega_{4} + |(\omega_{1} + \omega_{2} - 2\omega_{3} + \omega_{4})^{2} + 4\omega_{3}\omega_{4}|^{1/2}$$
(I)

nessa **ā**rea de estudo vamos nos referir apenas a um pequeno numero de informações que podem ter alguma relevância em relação ao nosso trabalho. Falaremos inicialmente de sistemas constando de halogen<u>e</u> tos alcalinos contendo apenas impurezas divalentes.

Para a grande maioria de impurezas jā estudadas, pode-se afirmar que a vacância estā sempre em uma posição vizinha mais próxima (nearest neighbour - nn) ou próxima do vizinho mais próximo (next nearest neighbour - nnn) e que a orientação do dipolo I-V, em um campo elétrico, ocorre principalmente devido ao movimento de vacâncias ao redor da impureza ². Este movimento é descrito por equações diferenciais¹ em termos de quatro frequências diferentes de saltos: ω_1 corresponde ao salto da vacância de uma posição nn p<u>a</u> ra outra nn, ω_2 corresponde a troca direta entre a vacância e a impureza divalente, ω_3 é a frequência de salto da vacância de uma posição nn sição nnn para uma nn e ω_4 ao salto da vacância de uma posição nn para outra nn.

Todos estes processos são termicamente ativados e a relação entre as frequências de salto e a temperatura é dada por:

$$\omega = \omega_{e} e^{-\frac{\Delta \varepsilon}{KT}}$$

onde ω_o ē a frequência tentativa para a vacância vencer a barreira de potencial com altura Δε e K ē a constante de Boltzmann e T ē a temperatura absoluta.

As equações de Lidiard foram resolvidas, para um campo elétrico constante, por Dreyfus³, obtendo dois tempos que governam o processo de relaxação:

$$\tau_{1}^{-1} = \omega_{1} + \omega_{2} + 2\omega_{3} + \omega_{4} + |(\omega_{1} + \omega_{2} - 2\omega_{3} + \omega_{4})^{2} + 4\omega_{3}\omega_{4}|^{1/2}$$
(I)

- 03 -

$$\tau_{2}^{-1} = \omega_{1} + \omega_{2} + 2\omega_{3} + \omega_{4} - | (\omega_{1} + \omega_{2} - 2\omega_{4})^{2} + 4 \omega_{3} \omega_{4} |^{1/2}$$
(II)

Para a maioria das impurezas estudadas a probabilidade da troca direta entre a impureza divalente e a vacância é muito menor que a probabilidade da vacância girar em torno da impureza (Dreyfus et al). Descreveremos a seguir, de modo bastante sumário, algumas consequências destes movimentos do complexo impureza-vacâ<u>n</u> cia em cristais de halogenetos alcalinos dopados com divalentes.

a) - Condutividade Iônica:

e

A condutividade iônica em cristais dopados com impurezas divalentes ocorre predominantemente devido a mobilidade de vacâncias². Sabe-se da literatura que a condutividade para temperaturas não muito altas é proporcional ao número de divalentes na rede. I<u>s</u> to significa que o número de vacâncias é controlado pelo número de divalentes. Para altas temperaturas a condutividade torna-se ind<u>e</u> pendente do número de divalentes, sugerindo que vacâncias são termicamente produzidas. Mais recentemente, Dreyfus e A.S. Nowick⁴ d<u>e</u> monstraram a existência de uma região de temperaturas onde a cond<u>u</u> tividade se deve ao par associado impureza-vacância.

No presente trabalho estamos interessados apenas em medir a energia de ativação para o movimento da vacância na faixa de te<u>m</u> peraturas em que o número delas é controlado pelo número de impurezas divalentes.

Para se obter uma expressão para a condutividade, devemos ter em mente, que a probabilidade por unidade de tempo para um fon saltar a barreira de altura ε é dada por⁵:

 $r \sim v e^{-\epsilon/KT}$ (1)

onde v é a frequência de vibração atômica.

Consideremos dois planos paralelos de atomos separados por uma distância <u>a</u> (constante da rede). Iremos supor que existe um gradiente de concentração de vacância em um plano dado por N e no outro plano (N + $\frac{adN}{dx}$). Os números de vacâncias em cada pl<u>a</u> no sera dado por Na e (N + $\frac{adN}{dx}$)a. O número resultante de vacâncias que atravessam uma area unitária por unidade de tempo s<u>e</u> ra dado por:

$$(Na + a^2 \frac{dN}{dx}) r - Nar \approx ra^2 \frac{dN}{dx}$$

Lembrando-se que J = - D $\frac{\partial N}{\partial x}$ (1^a Lei de Fick para especime linear) podemos tomar o coeficiente de difusão da vacância D_i como sendo D_i = ra², ou seja, D_i = va² exp (- $\frac{\varepsilon}{\kappa T}$).

O coeficiente de difusão para o cristal é achado mul tiplicando-se a fração <u>p</u> do número de fons que podem se mover p<u>e</u> lo coeficiente de difusão D_i, jã que estes fons são adjacentes ãs vacâncias; assim

$$D = pD_i = (pva^2) exp (- \epsilon/KT)$$

Combinando esta expressão com a relação de Einstein KT_{μ} = eD onde μ é a mobilidade e <u>e</u> a carga eletrônica. Vem que:

$$\frac{KT\mu}{e} = (pva^2) exp (- \varepsilon/KT)$$

ou seja

$$\mu = \frac{p \nu a^2 e}{KT} \exp \left(- \epsilon / KT \right)$$

- 05 -

como σ = nµe onde n e a concentração de vacâncias, vem que:

$$\sigma = \frac{ne^2 p va^2}{KT} exp (- \varepsilon/KT)$$
(1)

sendo p independente da temperatura, a inclinação do gráfico de $lu\sigma T \propto \frac{1}{T} da$ a energia de ativação para o salto da vacância de ion positivo, que queremos medir. Segundo Nowick e Dreyfus⁴ o gráfico de $lu\sigma T \propto T^{-1}$ é dividido em três regiões:



4

<u>Região I</u>: (intrínseca) é a região para o qual n é a concentração de equilíbrio de defeitos Schottky¹. Nesse caso o $\frac{n}{N} \propto \exp(\frac{-\varepsilon_s}{2KT})$ (2)

ε_s é a energia de formação do par de Schottky, N é a concentração de cátions nos sítios da rede.

Combinando a equação (1) com (2) temos que a energia efetiva de ativação para a região I (ϵ_{T}) é dada por:

$$\varepsilon_{I} = \varepsilon + \frac{1}{2} \varepsilon_{s}$$

Quando o número de vacâncias produzidas por introdução de impurezas divalentes é maior que o número de vacâncias produzidos termicamente, a condutividade muda e tem-se a região II. Nesta região a concentração de vacâncias cationicas é constante e igual a concentração de ions divalentes. Logo pode-se afirmar que a condutividade deve-se unicamente a mobilidade de vacâncias geradas por impurezas divalentes.

Na região II as vacâncias são ĝeradas pela impurezas divalentes mas estão dissociadas destas, logo a energia efetiva de ativação é igual à energia de movimento da vacância na rede ε_m , ou seja

$$E_{II} = \varepsilon_{m}$$

Na região III, a condutividade é controlada pelo par associado i<u>m</u> pureza-vacância. Isto significa que para a vacância se deslocar na rede é necessário primeiro desfazer o par associado impureza vacância.

Segundo Dreyfus⁴, a concentração de defeitos para esta região é dada por:

$$u \sim (\frac{N_{M}o_{N}}{Z})^{1/2} \exp(-\frac{\epsilon_{A}}{2KT})$$

onde N_Mo é a concentração total de impurezas divalentes e Z é o n<u>ú</u> mero de configurações possíveis para a associação, e $\epsilon_A e$ a energia de ativação da vacância. Comparando este expressão com (1), encontra-se que a energia efetiva de ativação (E_{III}) é dada por:

$$E_{III} = \epsilon_m + \frac{1}{2} \epsilon_A$$

b) - Re-orientação dos dipolos I-V

Como jā mencionamos anteriormente, o complexo I-V se reorienta na presença de um campo elétrico. Para um melhor entendimen to desta re-orientação tomemos, por exemplo, as doze posições nn po<u>s</u> siveis para a vacância. Antes da aplicação do campo elétrico as pr<u>o</u> babilidades de ocupação dessas posições são iguais. Na figura 2 e<u>s</u> tão representadas as doze possíveis posições para a vacância em torno da împureza divalente:



FIGURA 2

Essas posições podem ser representadas por poços de potencial de profundidade ΔE . Após a aplicação do campo elétrico as vacâncias terão energias diferentes para diferentes planos. As vacâncias situadas no plano <u>a</u> possuirão energia $\Delta E - E_e$. As do plano <u>b</u> terão energia ΔE e as do plano <u>c</u> energia $\Delta E + E_e$. Ou seja, os saltos de vacâncias na direção do campo elétrico serão facilitados. Em outras palavras, a aplicação do campo elétrico provoca uma redi<u>s</u> tribuição na população de vacâncias. E esta redistribuição que gera uma polarização elétrica no cristal que pode ser detetada pela técnica de correntes termo-iônicas (ITC) como veremos depois.

O modelo teórico para este fenômeno foi desenvolvido por Liliard², que encontrou equações matemáticas para a dependência das concentrações de vacâncias (nas posições nn e nnn) com o tempo em função do campo elétrico aplicado.

A solução das equações de Liliard, como jã nos referi mos anteriormente, para um campo elétrico <u>dc</u> foram encontradas por Dreyfus. A expressão para a polarização em função do tempo é dada por:

0

$$p(t) - p_1 (1 - exp(-\tau_1^{-1}t) + p_2(1-exp(\tau_1^{-1}t))$$

onde $\tau_1^{-1} e \tau_2^{-1} s$ ão as expressões (I) e (II).

$$p_{2} = \frac{4a^{2}e^{2}N_{1}E}{3KT(2+\frac{\omega_{4}}{\omega_{3}})(\tau_{1}^{-1} - \tau_{2}^{-1})} \left[\tau_{1}^{-1}(1+\frac{\omega_{4}}{\omega_{3}}) - 2(\omega_{1} + \omega_{2} + \omega_{4}) \right]$$

$$P_{1} = \frac{4a^{2}e^{2}N_{1}E}{3KT(2+\frac{\omega_{4}}{\omega_{3}})(\tau_{1}^{-1} - \tau_{2}^{-1})} \left[2(\omega_{1} + \omega_{2} + \omega_{4}) - \tau_{2}^{-1}(1 + \frac{\omega_{4}}{\omega_{3}}) \right]$$

N_i **ë a concentra**ção de divalentes com vacâncias nas posições nn e nnn. E **ë o cam**po elétrico aplicado.

Portanto a polarização em um determinado tempo é composto de uma polarização rápida governada pela constante de tempo τ_1 e uma polarização lenta regida por τ_2 .

3. Correntes Termo-Iônicas (ITC)

Deve-se a Bucci e Fiesch ¹⁰ a introdução da corrente termo-iônica! (ITC) para o estudo de processos de relaxação.A té<u>c</u> nica de ITC tem se tornado bastante popular nos últimos anos, devido a sua sensibilidade na investigação de relaxação de dipolos elétricos em cristais iônicos com pequenas concentrações de impurezas. No caso de halogenetos alcalinos com impurezas divalentes a técnica de ITC permite obter medidas da energia de orientação do complexo I-V, do tempo de relaxação desse defeito com relativa se<u>n</u> sibilidade.

Descreveremos aqui, de forma sucinta, a teoria relacionada com a técnica de ITC, já que iremos utiliza-la no desenvolvime<u>n</u> to do presente trabalho. Como a densidade de corrente de despolar<u>i</u> zação (ou polarização), J(t) = $\frac{dP(t)}{dt}$, é uma grandeza macroscópica, o interesse é medi-la.

No intuito de se obter informações sobre as modificações cinéticas causadas pela presença, na rede, de impurezas, iremos supor que a amostra está sujeita a um campo elétrico E e que possui uma polarização <u>P</u>.

Apos a retirada do campo eletrico, a polarização decaira de acordo com a expressão:

$$\frac{dP}{dt} = -\frac{P}{\tau}$$
(1)

 $\tau \ \vec{e} \ o \ tempo \ de \ relaxação \ e \ \vec{e} \ dado \ por \ \tau = \tau_o exp(\frac{\varepsilon}{KT})$

 τ_{o} ē o inverso do fator de frequência e ε ē a energia de orientação do dipolo.

Substituindo τ na equação (1) fica:

$$dP = \frac{P}{\tau_{o}} \exp(-\epsilon/KT)dt$$
 (2)

Para resolvermos (2) necessitamos saber como a temperatura varia com o tempo. O usual, em ITC, é uma variação linear. Assim dt = $\frac{1}{b}$ dT e (2) torna-se

$$\frac{dP}{P} = -\frac{1}{\tau_0 b} \exp(-\epsilon/KT)dt$$
(3)

- 10 -

Integrando a equação (3), temos que:

$$P = P_{o} \exp\left(-\frac{1}{\tau_{o}b} \int_{T_{o}}^{T} \exp\left(-\epsilon/KT\right)\right) dT' \qquad (4)$$

onde P_o é a polarização para a temperatura T_o (polarização ini - cial).

Derivando P com relação ao tempo para se obter a densi dade de corrente, temos

$$J(T) = \frac{P_{o}}{\tau_{o}} \exp \left[-\frac{1}{\tau_{o}^{b}} \int_{T_{o}}^{T} \exp(-\epsilon/KT') dT' \right]$$
(5)

O espectro da densidade de corrente, J(T), em função da temperatura (ou tempo) pode dar informações sobre os parâmetros P_0 , τ_0 e ϵ .

4. Cristais Duplamente dopados

Recentemente iniciou-se o estudo de defeitos em cristais iônicos dopados com impurezas monovalentes negativas e divalentes positivas.

Os trabalhos publicados nessa ārea concluem que as modificações na rede, devido a introdução de uma impureza negativa, a<u>l</u> teram sensivelmente a cinética do complexo impureza-vacância. Para melhor entendimento destas alterações, descreveremos brevemente a<u>l</u> guns destes trabalhos.

<u>R.Robert et al</u> $\frac{6}{2}$ estudaram cristais de KCl + KBr + CaCl₂ e KBr + KCl + CaBr₂.utilizando a técnica de ITC e medidas de perda dielétrica. No cristal de KBr 1% KCl + 10⁻³ CaBr₂ observaram a existência de dois picos de despolarização, em contraste com o KBr + CaBr₂ que apresenta apenas um pico. A existência do segundo pico em tempenatura inferior, é atribuida ao complexo I-V próximo a impureza negativa. Ou seja, a presença do fon Cl⁻ diminue a barreira de potencial para o salto da vacância em torno do novo complexo.

N.

Para o cristal de KCl + 1% KBr + 10⁻³ CaCl₂ não foi observado a existência do segundo pico. Esse efeito parece dever-se ao maior raio iônico da impureza negativa, quando comparado ao ânion da rede.

<u>S.C.Zilio</u>⁷ estudou o processo de aprisionamento do complexo I-V d<u>e</u> vido a introdução de impurezas negativas, em cristais de KI. Dos diversos sistemas estudados (KI + 10^{-3} CaI₂, KI + 0,1% KBr + 10^{-2} CaI₂, KI + 1% KBr + 10^{-3} CaI₂, KI + 1% KCl + 10^{-3} CaI₂, KI + 3%KBr + 10^{-3} BaI₂, KI + 1% KCl + 10^{-3} BaI₂, KI + 1% KCl + 10^{-3} SrI₂), observou-se que:

 a) - Impureza negativa de raio iônico pequeno funciona como armadilha para o complexo I-V. b) A velocidade de agregação do complexo I-V é maior para impurezas negativas de menor raio.
 c) A energia de ativação perto do centro de captura é tanto menor quanto menor for o raio da impureza negativa.

<u>Motoji Ikeya</u>⁸ estudou o cristal de NaCl + NaF + MnCl₂, usando té<u>c</u> nicas de ITC, EPR e Condutividade, observando que a energia de r<u>o</u> tação da vacância em torno do ion divalente é consideravelmente r<u>e</u> duzida devido a presença do fluor, raio iônico pequeno, como impureza negativa. Os resultados experimentais obtidos foram interpretados admitindo que a vacância é mais estável na posição nnn e atr<u>i</u> buindo esse efeito à presença do ion F⁻, próximo ao complexo I-V. O espectro de ITC para este cristal apresenta quatro picos de desp<u>o</u> larização. O pico de mais alta temperatura é atribuido ao dipolo

- 12 -

I-V não perturbado e os outros três a diferentes caminhos de reori entação que o dipolo I-V adquire devido a presença do ion fluor. <u>D. Pinatti⁹</u> estudando cristais de NaCl + NaF + PbCl₂, usando técnicas de ITC e absorção ótica, concluiu que o fluor também serve de armadilha para o complexo impureza-vacância. Observou quatro picos de ITC. O de mais alta temperatura, atribuido ao dipolo I-V não perturbado pelo fluor, converte-se nos dois picos intermediários enquanto o cristal envelhece. O quarto pico, que não aprese<u>n</u> ta modificações com o tempo, ainda é de origem desconhecida (talvez divacâncias, segundo seu trabalho). Os dois picos intermediários também são interpretados como devidos a diferentes caminhos para a reorientação do par I-V perturbado pela impureza negativa.

A diversidade entre os resultados e interpretações de Ikeya⁸ e Pinatti⁹ parece residir no tratamento térmico das amostras. As amostras usadas por Ducina Pinatti receberam "quench" de 720[°]C assegurando a distribuição inicial aleatoria das impurezas na matriz. Ikeya não se refere a tratamento térmico em seu trabalho, fazendo crer que a possibilidade de agregação mais extensa não foi levada em conta.

CAPÍTULO 2

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

1. Amostras:

As amostras utilizadas nesse trabalho foram crescidas no Instituto de Física e Química de São Carlos, através do método de Czochralshi. As percentagens de impurezas referidas no que se segue correspondem as quantidades acrescentadas ao material fundido quando do puxamento do cristal. Nenhuma análise química posterior foi feita nesses cristais.

Tipicamente, as amostras foram clivadas de modo a terem 1 cm² de area com espessura que variava entre 0,5 e 1 mm.

O processo de "quenching" a que nos referiremos mais adiante, consiste em levar as amostras jã clivadas a uma temperatura de 700° C durante cerca de 10 minutos e depois resfria-las r<u>a</u> pidamente sobre uma placa metalica, até atingir a temperatura ambiente. Calculamos que esse "quenching" se efetue em cerca de 30 segundos.

A amostra a ser usada nas medidas de ITC ou de condutividade tinha suas faces pintadas com tinta de prata para facili tar os contatos elétrico e térmico, na ponta do criostato.

2. ITC

De uma maneira geral, os passos para se obter um espectro de ITC são os seguintes:

a) - Leva-se a amostra até uma temperatura de polarização T_p. O conhecimento desta temperatura é muito importante por que

existe maior facilidade em orientar a maioria dos dipolos no cristal, isto é, uma maior probabilidade de orientação do complexo I-V.

- b) Aplica-se um campo elétrico constante, na temperatura de pol<u>a</u> rização, durante um tempo de polarização t_p. Esse tempo deve ser muito maior que a vida média do dipolo, em uma determinada orientação.
- c) Após esse tempo, resfria-se rapidamente a amostra até uma tem peratura muito abaixo da temperatura de polarização, onde o tempo de relaxação torna-se muito grande. Por conseguinte a polarização é congelada. Essa temperatura de congelamento, na maioria dos nossos casos, é a temperatura do nitrogênio líqui do (77 K).
- d) Retira-se o campo elétrico, conecta-se o eletrômetro, esperase que a corrente de fundo caia a pequenos valores. Depois di<u>s</u> to a amostra é aquecida linearmente e a corrente de despolarização é medida.

FIGURA 3



Para se conseguir o espectro de ITC, foi utilizado um criost<u>a</u> to desenvolvido e construido no Instituto de Física e Química de São Carlos. A amostra era colocada nesse criostato, submetida a altovácuo (melhor que 10^{-5} torr), polarizada e congelada à temperatura do nitrogênio líquido. Para a polarização da amostra, utilizou-se uma fonte DC da Keithley mod. 245. Para se medir a corrente usou-se um eletrômetro também da Keithley mod. 610 C, um registrador H.P. mod. 7100 BM. Para a leitura da temperatura foi usado um termopar cobre-constantan acoplado a um milivoltímetro digital da Keithley mod. 160 B. O diagrama abaixo descreve a montagem do equipamento.

....



FIGURA 4

O aquecimento linear da amostra era obțido utilizando-se uma resi<u>s</u> tência de ferro de soldar de 100 W de potência, conjugada a um divisor de tensão, de modo a se obter uma taxa de variação da temper<u>a</u> tura da ordem de 0,05 graus por segundo.

.....

As curvas experimentais obtidas eram ajustadas em um pr<u>o</u> grama de computador que calcula os vários parâmetros relacionados com os processos de relaxação.

Uma vez fornecido ao computador os valores de temperatu ra e corrente, o programa ajusta, aos dados experimentais, a melhor curva teórica usando o método de mínimos quadrados. O algorítmo uti lizado para o ajuste foi desenvolvido pelo Prof. Francisco Alcides Germano (do Departamento de Física da UFC) e está descrito no apên dice A. O resultado desse ajuste nos fornece, não so os valores da energia de ativação, tempo de relaxação e area de cada pico, ja des contado o back-ground, como também imprime o gráfico dos pontos ex perimentais e calculados da corrente em função da temperatura. Utilizamos também, nesse trabalho, um traçador de gráficos acoplado ao terminal do computador, que interpola segmentos de reta entre dois pontos calculados apresentando simultaneamente a curva experimental e a teórica normalizadas. Para a obtenção de correntes termo-iônicas a baixas temperaturas foi utilizado um "dedo frio" da Air Products modelo D.E. 202.S. Esse equipamento consta de uma ponta onde e colo cada a amostra que pode ser resfriada por um processo de expansão e compressão de helio em circuito fechado. Com isto é possível se atingir temperaturas da ordem de 10K. A ponte foi modificada para permitir a polarização e despolarização térmica da amostra de modo que era possível obter-se picos de ITC a temperaturas de até cerca de 20 K.

O restante do equipamento de ITC era idêntico ao utiliza do nas medidas em temperaturas acima do nitrogênio liquido.

- 17 -

3. Condutividade:

....

O equipamento usado para a obtenção das curvas $ln\sigma T \times 1/T$ foi essencialmente o mesmo que o usado nas medidas de ITC. A única diferença residia no criostato utilizado, que teve de ser modific<u>a</u> do por dois motivos:

- A fim de se atingir a região II da curva de condutividade foi necessário chegar-se a temperaturas da ordem de 200°C.
- 2) O conjunto experimental completo, por razões de construção dos vários instrumentos usados, teve de ser usado com "terra" flutuante (na aparelhagem de ITC, a terra era a própria car cassa do criostato).

As medidas de condutividade foram feitas aquecendo-se lentamente a amostra dentro do criostato e lendo-se ao mesmo tempo, a temperatura e a corrente elétrica através do cris tal, para uma voltagem aplicada fixa.

Em alguns casos, a medida foi feita ponto a ponto, esperando um certo tempo para que a temperatura se estabilizasse e lendo-se a corrente final obtida. No entanto, como não se observou nenhuma diferença sensível entre esse processo e o processo de aquecimento contínuo, esse último foi utilizado na maioria das vezes.

- 18 -

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Nesse capítulo descreveremos os resultados experimentais obtidos para os vários sistemas estudados. Para maior facilidade, separaremos esses resultados em duas partes: a) ITC e b) Condutividade.

a) ITC:

a.1) SISTEMAS KBr + 10^{-3} CaBr₂; KBr + 1% KCN + 10^{-3} CaBr₂

Apōs submetidas ao tratamento termico jā referido no capitulo ant<u>e</u> rior, as amostras de KBr + 10^{-3} CaBr₂ e KBr + 1%KCN + 10^{-3} CaBr₂ foram p<u>o</u> larizadas, durante 10 minutos ā temperatura de polarização, com tensões de 1600V e 1000V respectivamente. Os seus espectros apresentam sensiveis d<u>i</u> ferenças:

I) Enquanto $KBr + 10^{-3} CaBr_2$ possui apenas um pico de despolarização em 207K, o espectro do $KBr + 1\% KCN + 10^{-3} CaBr_2$ apresenta três picos em torno de 196K (pico A), 166K (pico B) e 40K, figuras 6, 7 e 8.

II) Após o ajuste dos espectros, os valores da energia de ativação encontrados foram de 0,38eV para o KBr + 10^{-3} CaBr₂, de 0,46eV e 0,36eV respectivamente para os picos A e B do KBr + 1% KCN + 10^{-3} CaBr₂. Esses valores representam a média em 4 medidas, sendo tomadas sempre as primeiras polarizações. Para o pico de 40K o valor da energia encontrada foi de 0,07eV.

III) Os tempos de relaxação apresentaram variações de algumas ordens de grand<u>e</u> za nas quatro medidas tomadas. Os valores aproximados para esses tempos são de ordem de 10^{-10} s para o pico A e de 10^{-9} s para o pico B.

a.2) SISTEMAS KBr + 1% KCN + 10^{-3} SrBr₂

As amostras de KBr + 1% KCN + 10⁻³ SrBr₂, após serem tratadas te<u>r</u> micamente, eram polarizadas durante 10 minutos a temperatura de polarização,com tensão de 1300V. O espectro desse cristal também apresenta dois picos de despo

_ 19 _

larização acima da temperatura do nitrogênio líquido. As temperaturas de seus máximos estão em torno de 215K para o pico A e de 174K para o B, figura 9. Em quatro medidas realizadas o valor médio da energia de ativação para o pico A vale 0,57eV e para o pico B o valor encontrado foi de 0,41eV. Sobre os tempos de relaxação também encontramos variações de algumas ordens de grandeza. a.3) SISTEMAS NaCl + 1% NaCN + 10^{-3} CaCl₂, NaCl + 1% NaCN + 10^{-3} SrCl₂ + 1%KCN + 10^{-3} CaCl₂, KCl + 1%KCN + 10^{-3} SrCl₂

As amostras desses cristais foram submetidas ao mesmo tratamento térmico que as anteriores e polarizadas por 10 minutos com tensão de 1500V. Os seus espectros parecem apresentar apenas um pico de ITC, figuras 10 a 12. Ao serem ajustadas, os espectros apresentam valores irreais, como tempo de relax<u>a</u> ção negativos ou extremamente grandes. Essa irregularidade nos parâmetros de<u>s</u> ses ajustes nos levam a duvidar que exista apenas um pico de despolarização. O que pensamos, na verdade, é que essa banda é o resultado da soma de mais de um pico. Foi tentado ajuste para dois picos mas também não foi alcançado nenhum r<u>e</u> sultado significativo.

a.4) ENVELHECIMENTO DOS CRISTAIS DE KBr + 1%KCN + 10⁻³CaBr₂ e KBr+1%KCN+10⁻³SrBr₂

Na tentativa de entendermos melhor a agregação de defeitos em cri<u>s</u> tais mistos, realizamos medidas das áreas dos picos em função do tempo.

Para recolhermos os dados sobre essa agregação, adotamos o seguinte procedimento: a amostra era aquecida a 700⁰C durante 10 minutos, para garantir uma distribuição caótica das impurezas. Em seguida, resfriada rapidamente a tem peratura ambiente. As faces eram pintadas e a amostra colocada no criostato. E<u>s</u> tabelecia-se um vacuo melhor que 10^{-5} torr. Procedia-se a polarização da Amostra. 0 tempo gasto entre o quench e a polarização era de 10 minutos.

Após o recolhimento do primeiro espectro, a amostra era posta a env<u>e</u> lhecer a temperatura mabiente ou a 70^oC. De tempo em tempo, polarizava-se nov<u>a</u> mente a amostra e tirava-se um novo espectro. As áreas de cada pico eram medidas. Alguns desses espectros estão mostrado nas figuras 13 e 14. Nota-se, apesar da dispersão dos resultados, que existe uma tendência do defeito responsável pelo pico A a se converter no defeito que gera o pico B. Nota-se também uma ligeira v<u>a</u> riação nas temperatura do máximo de cada pico. Outra observação que podemos fazer

- 20 -

é que não há conservação da soma das áreas. Todas essas conclusões, para uma série típica, estão resumidas nas tabelas 1, 2 e 3.

Durante a realização de outras séries, para confirmação de resultados, observamos que em determinadas amostras a transfo<u>r</u> mação do pico A em pico B se fazia rapidamente e após algum tempo os dois picos desapareciam, dando lugar a apenas um pico em temp<u>e</u> ratura diferente dos dois originais, figura 15.

Esse comportamento sugeria a possibilidade das conce<u>n</u> trações de impurezas serem diferentes para diferentes amostras. No intúito de confirmar essa possibilidade, foram feitas medidas em cristais com maior concentração <u>nominal</u> de impurezas negativas. Ficou constatado que a velocidade de agregação aumenta quando se aumenta a percentagem de impurezas monovalentes.

a.5) ITC A BAIXAS TEMPERATURAS

Foram encontradas bandas de ITC a temperaturas abaixo do nitrogênio líquido em vários sistemas duplamente dopados, como KBr + KCN + Ca, NaCl + NaCN + Ca e KI + KCN + Ca.

A figura 8 mostra o pico de ITC obtido para o sistema KBr + 1%KCN + 10^{-3} CaBr₂. A temperatura corresponde ao máximo de<u>s</u> te pico de ITC é de T_m = 40K, com energia E = 70meV.

b) CONDUTIVIDADE:

Com intúito de entender quais as modificações na cond<u>u</u> tividade iônica devido a introdução de impurezas negativas na rede, levantamos a curva $ln\sigma T \times T^{-1}$ para diversos cristais contendo ions CN⁻ como impureza. O procedimento para a obtenção desses espectros, está descrito no capitulo anterior.

Descreveremos a seguir os resultados para os diversos sistemas estudados.

- 27 -

b.1) SISTEMAS KBr + 10^{-3} CaBr₂, KBr + 1%KCN + 10^{-3} CaBr₂

O espectro de condutividade para o KBr + 10^{-3} CaBr₂ apr<u>e</u> senta uma energia de ativação para a região III de 1,05eV. Para o KBr + 1%KCN + 10^{-3} CaBr₂ a energia de ativação para a mesma região é de 0,93eV, o que nos leva a concluir que a presença do fon CN⁻ na rede, como impureza, diminue a energia de associação entre a impureza e a vacância. Os espectros do KBr + 10^{-3} CaBr e KBr + 1%KCN + 10^{-3} CaBr₂ estão mostrados nas figuras 16 e 17.

b.2) SISTEMAS NaCl + 1%NaCN + 10^{-3} CaBr₂, KCl + 1%KCN + 10^{-3} CaBr₂

Levantamos também os espectros para o NaCl + 1%NaCN + 10^{-3} CaCl₂ e, encontramos uma energia de 0,98eV, e do KCl + 1%KCN + 10^{-3} CaCl₂ e o valor da energia encontrado foi de 0,76eV.





- 23 -







 $KBr + 1\% KCN + 10^{-3}CaBr_2$

- 25 -





- 26 -







- 28 -





- 29 -







- 20













2

+++ .1. . ++++



-++

...+ 2

...,

20

TABELA 1

<u>KBr + 1% KCN + 10⁻³CaBr₂ - Envelhecimento: Temperatura Ambiente</u>

5	÷		4	5		2	5				10	 		1.		 				-	5.7						

Frugihacimenta	Areas		Razão	Soma das Areas
	Pico A	Pico B.	A/ B	A . + B
10 minutos	2700	1687	1,60	4.387
16 horas	2662	1613	1,65	4.275
42 horas	2255	1583	1,42	3.838
67 horas	2311	1683	1,40	3.994
90 horas	1842	1656	1,11	3.498
168 horas	1882	1898	0,99	3.780
234 horas	1841	2270	0,81	4.111
333 horas	1185	1546	0,77	2.731
433 horas	1246	1463	0,85	2.709

TABELA 2

$\frac{\text{KBr} + 1\%\text{KCN} + 10^{-3}\text{CaBr}_2}{\text{Envelhecimento: } 70^{\circ}\text{C}}$

Fnyelbecimento	Are	as	Razão	Soma das Areas
	Pîco A	Pîco B.	A/B	A + B
10 minutos	4633	815	5,68	5.448
2 horas	2628	1813	1,45	4.441
4 horas	2770	1920	1,44	4.690
7 horas	2948	4145	0,71	7.093

- 35-

Env	(elbecimento	Āreas		Razão	Soma das Āreas
L II 1	Vernecrmento	Pico A	Pico B	A/B	A + B
10	Minutos	3400	566	6,00	3.966
17	Horas	3323	1055	3,15	4.378
49	Horas	2658	1270	2,09	3.928
117	Horas	2421	1252	1,64	3.673
193	Horas	2604	1475	1,76	4.079
293	Horas	2050	1820	[.] 1,13	3.870
360	Horas	2040	1650	1,23	3.690

TABELA 3

<u>KBr + 1%KCN + 10⁻³ SrB</u>r₂ - <u>Envelhecimento</u>: <u>Temperatura</u> <u>Ambiente</u>

TABELA 4

ITC	energ	ia (eV)	τ _o	(s)
Sistema	Pico A	Pico B	Pico A	Pico B
KBr+10 ⁻³ Ca ⁺⁺	0,38	-	5×10^{-9}	-
KBr+1%KCN+10 ⁻³ Ca ⁺⁺	0,46	0,36	10-10	10-9
KBr+1%KCN+10 ⁻³ Sr ⁺⁺	0,57	0,41	10-12	10-10
4				

CAPÍTULO 4

DISCUSSÃO:

a) Influência do fon CN⁻ na reorientação dos complexos I-V

A presença do fon CN⁻ em cristais de KBr dopados com cálcio, modifica o espectro de ITC. Enquanto KBr + CaCl₂ aprese<u>n</u> ta um único pico de ITC em torno de 210K, o cristal de KBr + KCN + CaCl₂ apresenta dois picos, um em torno de 198K (pico A) e outro em 166K (pico B). Essa modificação é atribuida a dois tipos de complexo I-V no cristal, com o fon CN° como vizinho e sem o CN⁻. Pode-se notar em nossas medidas que o pico de ITC provinien te da reorientação do complexo I-V sem CN⁻ perto, o de 198K, muda de energia. No cristal de KBr + Ca⁺⁺opico devido a reorientação do complexo I-V se da a 210K com E = 0,38 e V. No cristal de KBr + KCN + Ca encontramos o pico A em 198K, com E = Q,46 e V. Isto se dã, provavelmente, devido a deformação da rede causada pela intro dução da impureza negativa, que desloca os fons da matriz de suas posições originais, no sentido de diminuir o parâmetro da rede em regiões próximas à impureza monovalente. Já o pico de 166K devese a reorientação do complexo I-V com um ion CN vizinho. Se essa banda for ajustada em computador, como devido a um único processo de relaxação, obtem-se uma energia de orientação menor que a obti da para banda de mais alta temperatura. Isto pode ser indício de que a vacância é mais estável nessa posição, ou seja, fica mais ligada ao fon divalente devido a diminuição das barreiras de po tencial próximas à impureza divalente. No entanto, uma hipótese pode ser levantada aqui, de que o pico B não seja um pico de ape nas um tipo de relaxação. Teriamos na realidade vários processos provenientes de agregados de vários tipos dentro da rede constan

do talvez de uma impureza divalente com um número variável de ions CN⁻ nas vizinhanças. Isso poderia explicar a flutuação e<u>n</u> contrada nos valores de energia, tempo de relaxação e posição dos picos.

Os resultados que obtivemos com os sistemas mistos do tipo AX + A(CN) + MX₂ (onde A representa o cátion da matriz, X o ânion e M o îon de impureza divalente) estão de acordo com as observações de R. Robert⁶ e S.C. Zilio⁷ para outros sistemas mistos.

No nosso caso, a adição de um ĩon CN[•] a uma rede de KBr, por exemplo, equivale ao caso da adição de Cl[•] ao KBr. Isso é uma indicação de que o ĩon CN[•], para todos os efeitos, pode ser considerado esferőide. Na verdade, as observações de Lüty et al¹¹ jã mostraram que o ĩon CN[•] estã pulando rápidamente entre as oito posições <111> de modo a poder ser encarado como ĩon e<u>s</u> férico com, aproximadamente, 1,9Å de raio. O ĩon CN[•] tem forma elĩpsoidal e momento de dipolo, instantâneo, intrínseco que vale 0,07eA.

Nossas observações indicam que o ion CN^- se comporta como um ion esférico cujo raio deve ser igual ou inferior a 1,9A. A existência de um pico de ITC a 40K sugere que o ion CN^- pode estar levemente fora de centro, o que fortalece ainda mais o a<u>r</u> gumento que o CN^- comporta-se como ion menor que o ânion da rede de KBr. Isso mostra porque no KBr + KCN + CaBr₂ temos dois picos. Nos sistemas NaCl + NaCN + CaCl₂ e KCl + KCN + CaCl₂ o espectro de ITC mostra apenas um pico ligeiramente deformado. Essa defo<u>r</u> mação deve ser causada pelo menor parâmetro das redes quando co<u>m</u> parados com o KBr. Ou seja, para as matrizes de NaCl e KCl o ion CN⁻ não se comporta como um ion de raio menor que o ânion da onde os dois picos estão bem separados, nos cristais de NaCl e KCl também podem existir dois tipos de despolarização, so que eles possuem energias muito próximas e os picos A e B se inte<u>r</u> penetram. Na verdade o pico que aparece no espectro é a mistura dos picos A e B. Isso pode explicar o fato de não termos ajustes razoáveis quando tratamos esses picos como devidos a processos normais de relaxação, ou seja, apenas um tipo de relaxação.

Para a elaboração de um modêlo de barreiras de energia no caso genérico do KBr + KCN + CaBr₂ (tomaremos esse sistema como exemplo) consideraremos que a vacância tem energia mais baixa na posição do vizinho mais próximo (<u>nn</u>) da impureza div<u>a</u> lente.

Esse modêlo estã de acordo com o adotado por D. Pinatti⁹ para o caso do NaCl + NaF + CaCl₂, mas é diferente do modêlo de IKEYA⁸ para o NaCl + NaF + MnCl₂ que considerou a vacância como mais estável na posição nnn. Além de concordar com as observações de D. Pinatti, achamos que no caso do CN⁻ se a não esfericidade, instantânea, do ïon CN⁻ tiver alguma influência será no sentido de dar mais estabilidade a vacância na posição nn (em relação a nnn) já que ele aponta preferencialmente na direção <111>.

O-fon CN⁻ tem raio iônico efetivo que é intermediário entre o raio dos fons de Cl⁻ e Br⁻ ($R_{Br}^{-} = 1.95A$, $R_{CN}^{-} = 1.9A$, $R_{Cl}^{-} = 1.81A$). Pauling¹² refere-se ao CN⁻ como tendo comprimento de ligação 1.47A. Nossos resultados indicam que o raio iônico efetivo do CN⁻ deve ser aproximado do valor do raio iônico de Cl⁻.

Supondo então que o CN[®] é menor que o Br[®], vemos pela figura 18 que a energia de reorientação da vacância em torno da impureza deve ser alterada pela presença de um ion CN[®] na viz<u>i</u> nhança ao divalente.



Figura 18

No entanto, diferentemente do ĩon F[•] no NaCl + CaCl₂, a presença do CN[•] não faz com que os processos de relaxação nas direções paralelas ou perpendiculares ao eixo Ca⁺⁺ — CN[•] sejam diferentes. Por isso, esse complexo gera apenas um novo pico de ITC (e não dois) no caso do KBr + KCN + CaBr₂, e nenhum novo pico de ITC no caso do KCl + KCN + CaCl₂, devido ao fato de que os raios iônicos do Cl⁻ e CN⁻ serem aproximadamente de mesmo valor.

b) Influência do fon CN na condutividade iônica

A presença do ion CN⁻ na vizinhança do divalente alt<u>e</u> ra a condutividade iônica do sistema.No caso do KBr + $10^{-3}CaCl_2$ a energia efetiva de ativação na região de associação entre a impureza divalente a vacância (região III, que se extende até temperaturas além de 200⁰C) é de 1,05eV, por nossas medidas. Quando 1% de CN⁻ é acrescentado ao sistema KBr + CaBr₂ a energia efetiva decresce para 0,93eV na mesma região de temperatura. I<u>s</u> so indica uma diminuição na barreira de potencial que separa as posições nnn das posições não ligadas da vacância. Como a energia de movimento da vacância depois de separada das impurezas não deve depender senão do parâmetro da rede, essa variação de E_{III} na presença de um fon CN⁻ deve indicar uma alteração na energia de associação da vacância. Temos E_{III} = E_m + E_A/2 = 0,93eV. E_m pode ser obtido da região II, tanto no cristal de KBr + CaCl₂ quanto no cristal misto KBr + KCN + CaBr₂ e vale 0,66eV¹³. Daf obtemos E_A = 0,54eV para o cristal duplamente dopado. Para o cristal impurificado apenas com divalente E_A vale 0,78eV.

Desta forma podemos construir um modèlo de barreiras de energia para o sistema KBr + 1%KCN + 10⁻³CaBr₂, conforme vi<u>s</u> to na figura 19.



Figura 19

- 41 -

c) Agregação das impurezas

Devido ao nosso interesse em estudar a difusão das i<u>m</u> purezas dentro do cristal, tornou-se necessário tratar termic<u>a</u> mente as amostras no sentido de garantir uma distribuição caót<u>i</u> ca dessas impurezas.

Para o KBr + 1%KCN + 10⁻³CaBr₂ a primeira polarização, feita 10 minutos após o quench, apresentava apenas o pico de ITC devido ao complexo I-V, ou seja, o pico A. Isto nos leva a con cluir que nesse inficio de processo os fons CN⁻ não participam da reorientação do par I-V, a não ser indiretamente através de uma modificação efetiva do parâmetro da rede. Decorrido algum tempo, com a amostra posta a temperatura ambiente, nova polarização era feita. O pico B, devido a participação do CN⁻, começava a cres cer enquanto o pico A diminuia sua area, dando uma indicação cla ra que o pico A se converte no pico B. Isso significa que um nú mero cada vez maior de ïons CN[®] tornam-se vizinhos do par impure za - vacância. Entretanto, devido a não conservação da área to tal dos dois picos, parece existir também centros competidores (provavelmente complexos maiores, como dimeros, trimeros, etc.) que não possuem momentos dipolares, provocando a flutuação na area de cada pico, figura 13.

Foi feito também, para o cristal de KBr + 1%KCN + 10^{-3} CaBr₂, séries com as amostras postas a envelhecerem à temp<u>e</u> ratura de 70°C. Esse envelhecimento mostrou-se extremamente r<u>a</u> pido, conforme mostra a figura 15. Com o tempo (a 70°C) tanto o pico A como o B desaparecem, o que mostra que so restam co<u>m</u> plexos mais extensos. Depois aparece um novo pico A' com a te<u>m</u> peratura do máximo próxima da temperatura de A. Acreditamos que esse novo pico deva-se a reorientação de complexos I-V dentro

- 42 -

de precipitados que se formam na matriz. Essa hipótese concorda com observações feitas em cristais do tipo NaCl + PbCl₂ ou NaCl + CaCl₂ fortemente dopados¹⁴.

Fizemos também polarizações em cristais de KBr + 2%KCN + + 10^{-3} CaCl₂ e KBr + 3%KCN + 10^{-3} CaBr₂. No cristal com 2% de CN⁻, observou-se que o pico B é sempre maior que o A, por mais rápido que fizessemos a primeira polarização, indicando que o aumento do número de fons CN⁻ aumenta a chance de ligação do fon CN⁻ com os complexos I-V aumenta consideravelmente. Para uma amostra de KBr com 3% de KCN e 10^{-3} CaBr₂ o espectro de ITC obtido logo após o quench não apresenta os picos normais A e B, mas apenas uma extensa banda pouco definida. Isso indica que nesse sistema a precipitação das impurezas em agregados mais complexos é extremamente rápida.

d) Bandas de ITC em baixas temperaturas

.a. Tel

A presença de uma banda de ITC em torno de 40K no sistema KBr + KCN + CaBr₂ apresenta um problema para sua interpretação.

Na busca de um modêlo que explique a origem desse pico, levamos em conta os seguintes fatos experimentais:

- a) Nenhuma banda de ITC foi achada nessa região de temperatura em cristais dopados apenas com a impureza divalente.
- b) Nenhuma banda de ITC foi achada nessas temperaturas em cristais de halogenetos alcalinos dopados apenas com CN...

A observação (b) exclui a possibilidade desses sinais serem devidos a alguma ativação térmica dos dipolos intrínsecos CN⁻, o que jã era de se esperar pois a reorientação desses dip<u>o</u> los em direção <111> se faz por um processo de tunelamento. Aliãs, Julian e Lüty¹⁵ jã observaram que cristais de KCN com 10% ou^{**}mais de KCl não apresentam nenhum pico de ITC ab<mark>aixo da tempe</mark> ratura de nitrogênio líquido.

Um modelo tentativo sonsiste em admitir que o ion CN⁻ está ligeiramente deslocado de sua posição substitucional quando se encontra na vizinhança de uma impureza divalente. Dai pr<u>o</u> vém um momento dipolar elétrico possível de orientação por um campo externo e posterior ativação térmica dando origem à banda de ITC em baixas temperaturas.

Yokozawa e Kazumata¹⁶ jā fizeram a suposição que os Tons F⁻ em cristais de NaCl + NaF + MnCl_a podem estar fora de centro quando estão nas proximidades do divalente. Com efeito, em cristais de NaCl + NaF com diversos tipos de Tons divalentes observamos bandas de ITC em temperaturas em torno de 20K.

Um modelo definitivo para a explicação dessas bandas em baixas temperaturas deve esperar por mais resultados exper<u>i</u> mentais, inclusive com o uso de outras técnicas. O espalhamento Raman, por exemplo, onde seria estudada a banda "strech" do CN⁻, pode ser uma técnica valiosa no estabelecimento desse modêlo.

- 44 -

CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES:

Nos capitulos anteriores descrevemos e discutimos os resultados obtidos para os diversos sistemas estudados. Nesse c<u>a</u> pitulo descreveremos as conclusões a que chegamos nesse trabalho. Devido a grande flutuação dos resultados numéricos obtidos dos ajustes no computador, nosso trabalho é mais qualitativo que qua<u>n</u> titativo. Esta flutuação deve-se em parte, ao desconhecimento das concentrações exatas de impurezas nas amostras.

1) Os espectros de ITC para os cristais de KBr + 1%KCN + 10^{-3} CaBr₂ e KBr + 1%KCN + 10^{-3} SrBr₂ apresentam dois picos de despolarização. O pico A, em T = 198K, deve-se ao complexo I-V não perturbado pelo CN⁻ e o pico B, em T = 166K, deve-se ao complexo I-V com o ion CN⁻ como vizinho.

2) Para os cristais de NaCl + 1%NaCN + 10^{-3} CaCl₂ e KCl + 1%KCN + 10^{-3} CaCl₂, e também nos cristais com o Sr⁺⁺ como impureza divale<u>n</u> te, os espectros parecem apresentar apenas uma banda de ITC. Acreditamos, entretanto, que seja resultado de dois ou mais picos que se interpenetram.

3) A separação, ou não, dos picos de ITC está ligada a relação entre o raio iônico da impureza negativa e o parâmetro da rede. No KBr, o de maior parâmetro, os picos estão separados.

4) A existência de um pico de ITC a 40K, no cristal de KBr + 1%KCN + 10⁻³CaBr₂, sugere a possibilidade do ion CN⁻ estar fora de centro.

5) Das medidas feitas durante o envelhecimento das amostras de

KBr + 1%KCN + 10^{-3} CaBr₂ e KBr + 1%KCN + 10^{-3} SrBr₂, observou-se que o pico A tende a se converter em pico B, o que nos leva a concluir que o fon CN⁻ serve de armadilha para o par impureza vacância.

6) Estudando o envelhecimento em cristais de KBr + KCN + CaBr₂ com maiores concentrações (2% e 3%) de CN⁻ ou em temperaturas superiores à ambiente, verificou-se que a velocidade de agregação do complexo I-V aumenta com a concentração de impureza monovale<u>n</u> te.

7) Observou-se que a soma das āreas dos dois picos, nos sistemas KBr + KCN + CaBr₂ e KBr + KCN + SrBr₂, não se conserva durante o envelhecimento das amostras. Isto foi atribuído a formação de agregados maiores (dimeros, trimeros, etc.), ou precipitados.

8) Em algumas amostras com alta concentração de CN⁻, observou-se a fusão dos dois picos em uma única banda, com temperatura do máximo próxima à do pico A. Atribuímos a essa nova banda A' a re<u>o</u> rientação de entidades semelhantes ao complexo I-V dentro de pr<u>e</u> cipitados maiores, que se formam na matriz.

9) A presença do fon CN faz diminuir a energia de ativação en tre a impureza divalente e a vacância. Isto implica na diminuição da energia associada a liberação e movimentação das vacâncias (E_{III}) com o consequente aumento da condutividade. Valores para essas energias de ativação foram obtidos através de medidas da condutividade.

- 46 -

APÊNDICE

AJUSTE NORMALIZADO PARA OBTENÇÃO DE PARÂMETROS DE UM ESPECTRO DE ITC.

Este apêndice, descreve o ajuste normalizado que us<u>a</u> mos para a obtenção dos parâmetros das bandas de ITC. Essa no<u>r</u> malização foi desenvolvida pelo Prof. F.A.Germano, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Essa descrição pode ser útil a quem se interessar no ajuste de curvas de ITC.

Como jã vîmos no capitulo 1 deste trabalho, a densid<u>a</u> de de corrente de despolarização pode ser escrita como

 $J(t) = -\frac{dP}{dt} = \frac{P}{\tau} \qquad (1) \qquad \tau = \tau_0 \exp(E/KT)$

ou seja

$$\frac{dP}{P} = \frac{dt}{\tau}$$

integrando vem que:

$$P = P_{0} \exp\left\{-\int_{0}^{t} \frac{dt}{\tau}\right]$$
 (2)

onde
$$P_0 = \int_0^\infty J(t)dt$$
 (3)

assim a densidade de despolarização fica

$$J(t) = \frac{P_0}{\tau} \exp\left[-\int_0^t \frac{dt}{\tau}\right]$$
(4)

o máximo valor de J(t) ocorre quando $\frac{dt}{dt} = -1$ ou seja

$$T_{m}^{2} = \frac{b_{m}E\tau_{m}}{K} \qquad e \qquad b = \frac{dT}{dt}$$
(5)

Nessa expressão $b_m e \tau_m$ são os valores no tempo onde ocorre o máximo de despolarização.

O valor máximo de J(t) fica então:

$$J_{m} = \frac{P_{0}}{\tau(t_{m})} \exp\left[-\int_{0}^{t_{m}} \frac{dt}{\tau}\right]$$
(6)

Dividindo a equação (4) por (5) para se obter a normalização, fica:

$$\frac{J(t)}{J_{m}} = \frac{\tau(t_{m})}{\tau(t)} \exp\left[-\int_{t_{m}}^{t} \frac{dt}{\tau}\right]$$
(7)

Variaveis Normalizadas:

Tomemos T₁ como sendo o menor valor de temperatura em um determinado espectro e façamos $\theta = \frac{T}{T_1}$ onde T é a temperatu ra ao longo desse espectro. Substituindo também $\frac{E}{KT_1}$ por ε , a expressão (5) fica

$$\theta_{m}^{2} = \frac{b_{m}\tau_{0}}{T_{1}} \exp \left[\frac{E}{\theta_{m}}\right]$$
(8)

assim a equação (7) torna-se

$$J(t) = J_{m} \exp \left[\varepsilon \left(\frac{1}{\theta_{m}} - \frac{1}{\theta} \right) - \int_{t_{m}}^{t} \frac{1}{\tau_{o}} \exp \left(\frac{\varepsilon}{\theta} \right) dt \right]$$
(9)

desenvolvendo (9) vem

$$J(t) = J_{m} \exp \left[\varepsilon \left(\frac{1}{\theta_{m}} - \frac{1}{\theta} \right) - \frac{\varepsilon}{\theta_{m}^{2}} \int_{\theta_{m}}^{\theta} \frac{b_{m}}{b} \exp \left(\frac{\varepsilon}{\theta_{m}} - \frac{\varepsilon}{\theta} \right) d\theta \right]$$
(10)

Cada pico contribui para J(t) somente numa região pequena em torno de T_m. Nessa região b é aproximadamente constante e $\frac{b_m}{b} \approx 1$ (mesmo que b varie bastante do início ao fim de um longo espectro). Assim:

$$J(t) = J_{m} \exp \left[\epsilon \left(\frac{1}{\theta_{m}} - \frac{1}{\theta} \right) - \frac{\epsilon}{\theta_{m}^{2}} \int_{\theta_{m}}^{\theta} \exp \epsilon \left(\frac{1}{\theta_{m}} - \frac{1}{\theta} \right) d\theta \right]$$
(11)

Calculemos agora a integral que aparece na expressão (11). Façamos

$$\int_{\theta_{m}}^{\theta} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{\theta}\right) d\theta = \varepsilon \int_{-\frac{\varepsilon}{\theta_{m}}}^{-\frac{\varepsilon}{\theta}} \frac{e^{x}d_{x}}{x^{2}}$$
(12)

- 49 -

Para x < 0, a expressão acima pode ser escrita como

$$\int_{-\infty}^{X} \frac{e^{X}}{x^{2}} dx = \frac{e^{X}}{x^{2}} + 2 \int_{-\infty}^{X} \frac{e^{X}}{x^{3}} dx$$

$$= \frac{e^{X}}{x^{2}} + 2 \frac{e^{X}}{x^{3}} + 3! \int_{-\infty}^{X} \frac{e^{X}d_{X}}{x^{4}} \quad \text{ou seja}$$

$$= \frac{e^{X}}{x^{2}} + 2 \frac{e^{X}}{x^{3}} + 3! \frac{e^{X}}{x^{4}} + \dots + n! \frac{e^{X}}{x^{n+1}} + \dots$$

Assim a expressão (12) fica:

$$\int_{\theta_{m}}^{\theta} \exp(-\varepsilon/\theta) d\theta = \varepsilon \left[G\left(-\frac{\varepsilon}{\theta}\right) - G\left(-\varepsilon/\theta_{m}\right) \right]$$

Definindo a função F(x) como

$$F(x) = \frac{x_m^2}{x^2} e^{x_m^2 - x} (1 - \frac{2}{x} + \frac{3!}{x^2} - \frac{4!}{x^3} + \dots) \operatorname{com} x_m^2 = \frac{\varepsilon}{\theta_m}$$

a expressão (11) muda para

$$J(t) = J_{m} \exp \left[\frac{\varepsilon}{\theta_{m}} - \frac{\varepsilon}{\theta} - F(\frac{\varepsilon}{\theta_{m}}) + F(\varepsilon/\theta_{m}) \right]$$

- 50 -

Ou ainda, com H(x) = x + F(x), vem:

$$J(t) = J_{m} \exp (H(\epsilon/\theta_{m}) - H(\epsilon/\theta))$$
(13)

onde $H(x) = x + \frac{x_m^2}{x^2} e^{x_m - x} (1 - \frac{2}{x} + \frac{3!}{x^2} - \frac{4!}{x^3} + \dots) \operatorname{com} x_m \frac{\varepsilon}{\theta_m}$

De (6), obtem-se

$$J_{m} = \frac{P_{o}}{\tau(t_{m})} \exp\left[-\frac{\varepsilon}{\theta_{m}^{2}}e^{\varepsilon/\theta_{m}}\int_{\theta_{o}}^{\theta_{m}}e^{-\varepsilon/\theta}d\theta\right]$$

onde $\theta_0 = \frac{\epsilon}{KT_0} e T_0 \bar{e} a$ temperatura de polarização.

Assim
$$J_m = \frac{P_o}{\tau(\theta_m)} \exp \left[-F(\varepsilon/\theta_m) + F(\varepsilon/\theta_o) \right]$$
 onde $F(\varepsilon/\theta_o) \approx 0$

Substituindo $\tau(\theta_m)$, vem que

$$P_{o} = J_{m} \tau_{o} \exp\left[\frac{\varepsilon}{\theta_{m}} + F(\varepsilon/\theta_{m})\right] = J_{m} \tau_{o} \exp(H(\varepsilon/\theta_{m}))$$
(14)

De (8) vem

$$\tau_{0} = \frac{\theta_{m}^{2}}{\varepsilon} + \frac{T_{1}}{b_{m}} = \frac{-\varepsilon/\theta_{m}}{\theta_{m}}$$
 que substituindo em (14) fica:

$$P_{o} = \frac{J_{m}\theta_{m}^{2} T_{1}}{\varepsilon b_{m}} e^{F(\varepsilon/\theta_{m})}$$
(15)

Para se determinar o valor de ε pode-se achar $\theta_{<} \in \theta_{>}$ que correspondem aos valores de temperatura que delimitam a meia largura do pico de ITC. Assim

$$\exp\left[H(\varepsilon/\theta_{m}) - H(\varepsilon/\theta)\right] = \frac{1}{2}$$
 ou

$$H(x_m) - H(x) = -ln2 = -0,693$$

que pode ser escrita aproximadamente como:

$$x_{m} + 1 - \frac{2}{x_{m}} - \left[x + \frac{x_{m}^{2}}{x^{2}} e^{x_{m} - x} (1 - \frac{2}{x})\right] + 0,693 = 0$$

Desprezando $\frac{2}{x_m}$, $\frac{2}{x}$ e fazendo $\frac{x_m^2}{x_m^2} \approx 1$ vem que

 $x_{m} - x - e^{x_{m} - x} + 1,693 = 0 e fazendo x_{m} - x = \delta x fica$

 $\delta x - e + 1,693 = 0$ resolvendo esta equação fica:

 $\delta x_1 = 0,9851 e \delta x_2 = -1,461$ ou que:

$$\varepsilon \left(\frac{1}{\theta_{m}} - \frac{1}{\theta_{>}}\right) = 0,9851 \quad e \quad \varepsilon \left(\frac{1}{\theta_{<}} - \frac{1}{\theta_{m}}\right) = 1,461$$

Somando estas expressões vem:

$$\varepsilon \left(\frac{1}{\theta_{<}} - \frac{1}{\theta_{>}}\right) = 2.446$$
 que pode ser escrita

4

•

como

.0.74

$$\varepsilon = 2,446 \quad \frac{\theta_{\langle}\theta_{\rangle}}{\theta_{\rangle} - \theta_{\langle}} \approx 2,446 \quad \frac{\theta_{m}^{2}}{\Delta\theta}$$

•

....

onde

 $\Delta \theta = \theta - \theta < \cdot \cdot$

REFERÊNCIAS

......

- | 01 | A.B. Lidiard: Hanbuch de Physik, editado por S. Fl\u00fcgge. Vol 20 pag. 246. Vol. 20.
- | 02| A.B. Lidiard: Proceedings of the Bristol Conference on Defects in Cristaline Solids, 1954 (The Physical Society, London 1955, pag, 283).
- 03| R.W. Dreyfus: Physical Rewiew, 121, 1675 (1961).
- | 04| R.W. Dreyfus and A.S. Nowick, Physical Rewiew, <u>126</u>, nº 4, 1367 (1962).
- | 05| C. Kittel "Introduction to Solid State Physics", John Wiley (1962).
- 06 R. Robert et al Phys. Stat. Sol. 59, 335 (1973).
- | 07| S.C. Zilio: Tese de Mestrado, Instituto de Física e Química de São Carlos, SP., (1976).
- 08 Motoji Ikeya: Journal of the Physical Society of Japan, <u>45</u>, nº 4,1313 (1978).
- 09 Dulcina M.G. Pinatti: Tese de Mestrado, Instituto de Física e Química de São Carlos, SP., (1979).
- 10] Bucci and Fieschi: Physical Rewiew Letter, 12, 16 (1964).

11 - F. Luty: Physical Rewiew, B10, 3677 (1974).

- | 12| Pauling: Química Geral, Ao Livro Técnico (1970)
- 13 J.N. Maycock: J. Appl. Phys. <u>35</u>, 1512 (1964).
- | 14| J. Euclides Oliveira: Tese de Mestrado, Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará (1981).
- 15 M. Julian and F. Luty: Ferroeletrics, 16, 201 (1977).
- 16 Yokozawa e Y. Kazumata: J. Phys. Soc. Japan, 16, 694 (1961).

- 54 -